

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 6 月 23 日 (2005.6.23)

【公開番号】特開 2003-115129 (P2003-115129A)
 【公開日】平成 15 年 4 月 18 日 (2003.4.18)
 【出願番号】特願 2001-306408 (P2001-306408)
 【国際特許分類第 7 版】

G 1 1 B 7/24

B 4 1 M 5/26

【F I】

G 1 1 B 7/24 5 3 5 H

G 1 1 B 7/24 5 0 1 Z

G 1 1 B 7/24 5 1 1

G 1 1 B 7/24 5 3 4 K

G 1 1 B 7/24 5 3 4 N

G 1 1 B 7/24 5 3 5 G

G 1 1 B 7/24 5 3 8 E

G 1 1 B 7/24 5 3 8 F

G 1 1 B 7/24 5 6 1 N

B 4 1 M 5/26 X

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 9 月 29 日 (2004.9.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光照射による結晶とアモルファスの相転移現象を利用した光記録媒体において、
 溝を形成した基板上に反射放熱層、第 1 の保護層、記録層、第 2 の保護層をこの順序で積層した構成とし、該第 2 の保護層は ZnS と SiO_2 の混合物よりなり、該記録層は Ge 、 Sb 、 Te を主たる構成元素とし、該反射放熱層は Ag 合金よりなる記録媒体であって、該第 2 の保護層上に接着層とカバー層を構成し、該第 1 保護層は ZnS と SiO_2 の混合物層と Al_2O_3 層の 2 層からなり、該 Al_2O_3 層が該反射放熱層側に位置することを特徴とする光記録媒体。

【請求項 2】

請求項 1 記載の光記録媒体において、

前記第 1 保護層の Al_2O_3 層の膜厚が、該第 1 保護層の ZnS と SiO_2 の混合物層の膜厚の $1/5$ 以上、 $1/2$ 以下であることを特徴とする光記録媒体。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 記載の光記録媒体において、

前記第 1 保護層の Al_2O_3 層の膜厚が、前記反射放熱層の膜厚の 0.20 以上、 0.80 以下であることを特徴とする光記録媒体。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 の何れかに記載の光記録媒体において、

前記カバー層にハードコートを形成したことを特徴とする光記録媒体。

【請求項 5】

請求項 4 記載の光記録媒体において、

前記ハードコート of 膜厚が $1\ \mu\text{m}$ 以上、 $5\ \mu\text{m}$ 未満である事を特徴とする光記録媒体。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 の何れかに記載の光記録媒体において、

前記基板の溝形状におけるグループの幅の平均がトラックピッチの 0.3 以上、 0.5 以下であることを特徴とする光記録媒体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

請求項 6 記載の発明では、請求項 1 乃至 5 の何れかに記載の光記録媒体において、前記基板の溝形状におけるグループの幅の平均がトラックピッチの 0.3 以上、 0.5 以下である、という構成を採っている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

請求項 6 記載の発明によれば、請求項 1 乃至 5 の何れかに記載の光記録媒体において、前記基板の溝形状におけるグループの幅の平均がトラックピッチの 0.3 以上、 0.5 以下である構成としたので、このような光記録媒体において、Ge、Sb、Te を主たる構成元素とした相変化記録層で高速、高密度記録が可能となる。